

LAPT

2SA1186

シリコンPNPエピタキシャルプレーナ型トランジスタ (2SC2837とコンプリメンタリ)

用途：オーディオ、一般用

■絶対最大定格 (Ta=25°C)

記号	規格値	単位
V _{CB0}	-150	V
V _{CEO}	-150	V
V _{EBO}	-5	V
I _C	-10	A
I _B	-2	A
P _C	100(T _C =25°C)	W
T _J	150	°C
T _{stg}	-55~+150	°C

■電気的特性 (Ta=25°C)

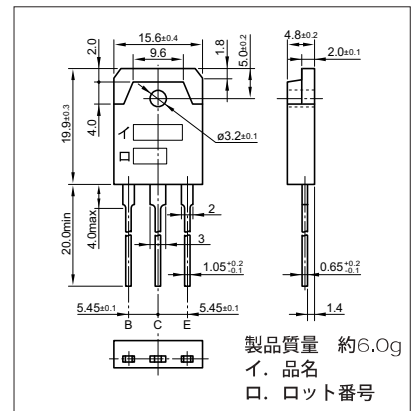
記号	試験条件	規格値	単位
I _{CB0}	V _{CB} =-150V	-100max	μA
I _{EBO}	V _{EB} =-5V	-100max	μA
V(BR) _{CEO}	I _C =-25mA	-150min	V
h _{FE}	V _{CE} =-4V, I _C =-3A	50min※	
V _{CE(sat)}	I _C =-5A, I _B =-0.5A	-2.0max	V
f _r	V _{CE} =-12V, I _E =1A	60typ	MHz
COB	V _{CB} =-80V, f=1MHz	110typ	pF

※ランク O(50~100), P(70~140), Y(90~180)

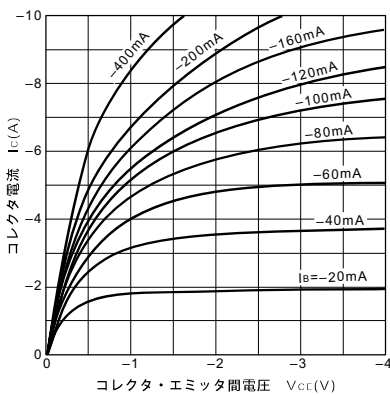
■代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V _{CC} (V)	R _L (Ω)	I _C (A)	V _{B2} (V)	I _{B1} (mA)	I _{B2} (mA)	t _{on} (μs)	t _{stg} (μs)	t _f (μs)
-60	12	-5	5	-500	500	0.25typ	0.8typ	0.2typ

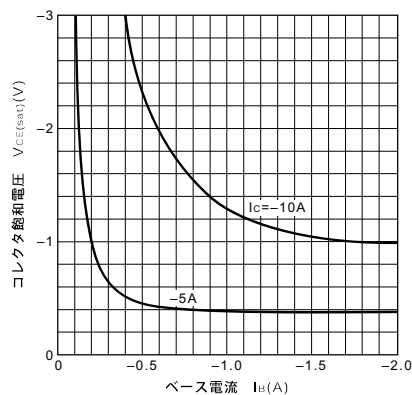
外形図 MT-100(TO3P)



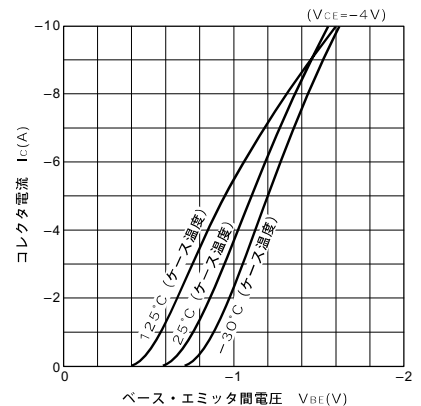
I_C-V_{CE}特性 (代表例)



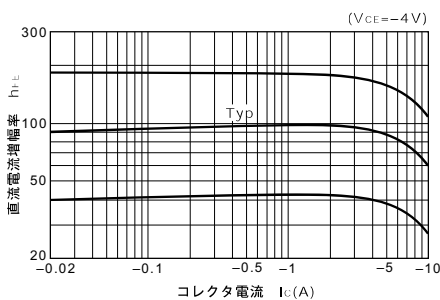
V_{CE(sat)}-I_B特性 (代表例)



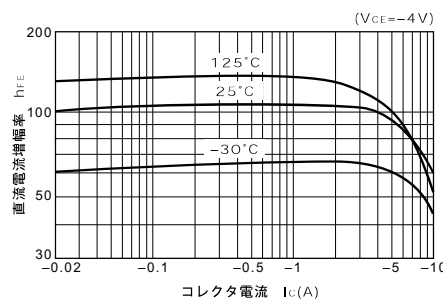
I_C-V_{BE}温度特性 (代表例)



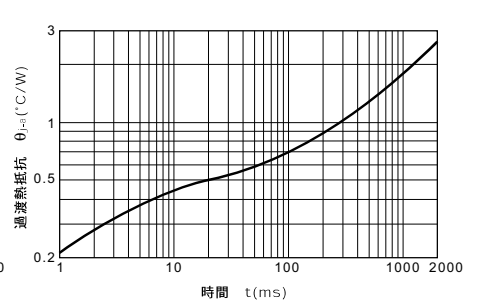
h_{FE}-I_C特性 (代表例)



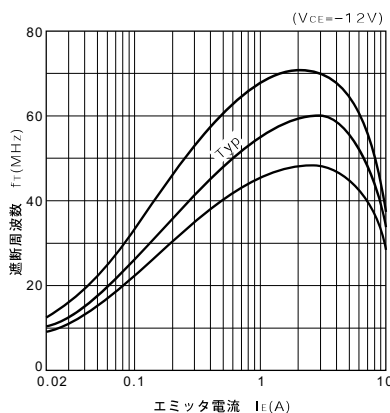
h_{FE}-I_C温度特性 (代表例)



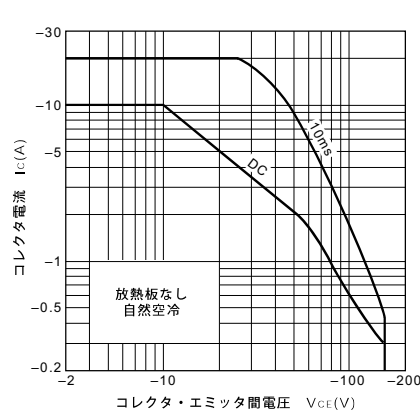
θ_{j-a}-t特性



f_T-I_E特性 (代表例)



ASO曲線 (単発パルス)



P_C-T_a定格

